

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成25年3月28日(2013.3.28)

【公開番号】特開2013-31842(P2013-31842A)

【公開日】平成25年2月14日(2013.2.14)

【年通号数】公開・登録公報2013-008

【出願番号】特願2012-187000(P2012-187000)

【国際特許分類】

B 0 1 J	19/08	(2006.01)
C 0 3 C	23/00	(2006.01)
C 0 4 B	41/80	(2006.01)
H 0 1 L	21/306	(2006.01)
B 0 8 B	7/00	(2006.01)
B 0 8 B	3/08	(2006.01)
H 0 1 M	8/02	(2006.01)
H 0 1 M	8/10	(2006.01)

【F I】

B 0 1 J	19/08	E
C 0 3 C	23/00	A
C 0 4 B	41/80	Z
H 0 1 L	21/306	F
B 0 8 B	7/00	
B 0 8 B	3/08	
H 0 1 M	8/02	P
H 0 1 M	8/10	

【手続補正書】

【提出日】平成25年1月4日(2013.1.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0084

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0084】

(n) 半導体の多層配線工程において、絶縁膜₂₃上に溝₂₀を設け、銅、アルミニウム、タンクスチレン、チタンなどの金属膜₂₁を埋め込み、絶縁膜₂₃上の不要な金属膜₂₁を除去するダマシンプロセス(Damascene process)にも利用できる。図4にダマシンプロセスの模式図を示す。図4において、a b cとプロセスが進み、cにて配線用金属のパターニングが形成される。

【手続補正2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図4】

